

存储在AI风口飘荡

A股存储板块,过去60天内已有9只个股涨幅超100%,其中3只个股涨幅突破200%:香农芯创以396.57%的区间涨幅领跑,江波龙位列第二,西安奕材以217.4%的涨幅跻身前三。

这股热度由AI浪潮与存储行业供需调整共同激发。从需求端看,AI技术正掀起存储革命:生成式AI、大模型训练对高带宽内存和大容量存储的需求呈爆发式增长;与此同时,消费电子升级、数据中心扩容,叠加5G、物联网、汽车电子的持续渗透,传统存储需求也在同步复苏,形成需求端的双重支撑。供给端则呈现调整态势:国际存储巨头纷纷切换战略,削减资本开支并淘汰DDR4等低端产品线,转而聚焦HBM、DDR5等高端领域,导致中低端存储供给缺口扩大。多重因素共同推动存储价格持续走高。

业绩增速惊人

江波龙日前在交易异常公告中援引CFM闪存市场报道称,从部分原厂释出的最新临时合约报价来看,覆盖服务器、手机及PC等各应用市场的DRAM与NAND产品价格最低涨幅20%,部分报价涨幅超过40%。

AI驱动的存储行业景气度,已实实在在转化为存储芯片企业的盈利增长,江波龙、澜起科技、兆易创新三家板块龙头的三季报颇具代表性。

江波龙的盈利增长直接受益于行业供需变化与自身业务推进。据江波龙2025年三季度报告及投资者关系记录披露,2025年三季度单季,公司营收65.39亿元,同比增长54.6%;归母净利润6.98亿元,同比暴涨1994.42%;扣非净利润4.47亿元,同比亦暴涨1162.09%。2025年前三季度,江波龙营收167.34亿元(同比增长26.12%),经营活动现金流净额9.22亿元(同比大涨183.43%)。

江波龙解释称,从驱动因素看,一方面是存储原厂产能向服务器倾斜,消费级存储供给紧张推升价格,另一方面公司企业级存储在国内头部客户中的导入进展顺利,海外业务保持高增长,两者共同推动盈利水平提升。

澜起科技2025年前三季度公司营收40.58亿元(同比增长57.83%),归母净利润16.32亿元(同比增长66.89%),扣非净利润14.67亿元(同比增长67.93%),增速显著跑赢行业。中银证券研报指出,若剔除三季度因股价上涨产生的3.53亿元股份支付费用,公司归母净利润已连续10个季度环比增长。这说明,澜起科技核心业务的盈利韧性并未受非经常性因素影响,而是随着存储行业复苏持续增强。

兆易创新亦凭借多产品线布局实现了业绩改善:2025年三季度公司单季营收26.81亿元(同比增长31.4%),扣非归母净利润4.98亿元(同比增长63.71%)。国信证券研报分析称,这一表现源于公司存储器、微控制器(MCU)、传感器三大板块的协同发力,进一步打开收入空间。

技术必须过硬

业绩的持续增长并非单纯靠行业涨价红利,机构普遍认为,三家公司在技术层面的布局,是其能持续受益于AI存储风口的关键——技术不仅帮它们抓住当前需求,更筑牢了长期竞争的基础。

截至三季度末,江波龙自研的主控芯片累计部署量已经突破1亿颗,搭载自研主控的UFS4.1产品已获得闪迪等国际原厂认可,并进入多家Tier1(一级供应商)终端客户的导入验证阶段。从市场价值看,UFS4.1是旗舰AI手机、IoT设备的核心存

储配置,而当前嵌入式存储正从eMMC向UFS加速升级,江波龙在调研中表示,公司判断“整体市场高度集中且具备广阔空间”。

海外三大厂商(三星、SK海力士、美光)退出利基市场导致的行业供给端紧张,则给了兆易创新相当可观的发挥空间。机构认为,在利基型DRAM领域,公司不仅受益于行业涨价,更通过技术优化实现毛利率提升,8Gb DDR4新品的应用使其能更好填补国际大厂退出低端市场后的供给缺口,在中低端DRAM市场站稳脚跟;而在NOR Flash领域,AI推动代码量增长带动大容量产品需求,公司定制化存储方案已与下游厂商合作推出端侧AI推理产品,先发优势能帮助其在这一新兴场景中快速占领市场;此外,公司在MCU领域的技术落地同样值得关注,车规级MCU A7系列已完成研发并取得项目定点,车规NOR Flash保持高速增长,数字能源领域与Navi-tas、南瑞的合作将MCU产品导入AI电源方案,进一步拓宽了技术的应用场景,增强了抗风险能力。

澜起科技的核心业务是内存接口芯片。凭借这一强项,公司早已在全球供应链中站到了颇为核心的位置。资料显示,内存接口芯片是内存模组(即内存条)的核心器件,作为CPU存取内存数据的必由通路,其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性,以匹配CPU日益提高的运行速度及性能。

据不完全统计,过去几年内,澜起科技曾多次获得行业龙头美光科技的“杰出供应商表现奖”及SK海力士“最佳供应商奖”等奖项,并曾与三星合作推出CXL™内存等多款产品,三家芯片龙头过去已经为并且后续或将继续为澜起科技带来可观营收。

巨头先后涨价

受益于AI时代下存储需求爆发推动,价格不断走高。

10月23日,三星和SK海力士向客户调整报价,DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%。10月24日,三星电子和SK海力士的总市值合计达到1019.535万亿韩元,史上首次超过1000万亿韩元。

近日又再次传出闪存龙头闪迪大幅涨价消息。

目前,闪迪已经将11月份的NAND闪存报价提高了50%,引发整个存储供应链震动,导致创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂暂停发货,并重新评估报价。根据中国闪存市场的数据,2025年10月DRAM指数环比上涨33.98%,NAND指数环比上涨29.69%。由于全球CSP扩充数据中心规模,带动整体DRAM价格上扬,TrendForce上调2025年四季度DRAM价格预测,预计四季度一般型DRAM价格涨幅从先前的8%~13%上调至18%~23%。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅表示:“海内外头部存储厂商年内已经多次调高产品价格。AI技术的迅猛发展,是推动存储市场需求高涨的根本动力。人工智能服务器和终端产品等对存储器数量和性能提出了更高要求,存储产业链上下游迎来‘超级周期’。”

对于本轮存储产品价格上调,苏商银行特约研究员付一夫表示:“与传统消费电子产品对存储产品的需求不同,人工智能技术的蓬勃发展对存储产品的存储速度、容量与功耗都提出更高要求,高端存储产品的需求呈现井喷式增长。”

上下游齐发力

对于存储行业后续走势,招商证券研报认为,进入2025年三季度以来存储行业全面进入加速上行周期,不同于此前供给侧减产或退出带来的价格短暂上行,本轮存储行业上行周期主要系AI时代下存储需求爆发推动,同时供给侧产能开出有限,因此行业供需缺口持续扩大,价格加速上涨。

摩根大通表示,“内存饥渴”趋势正在推动整个行业进入结构性增长阶段,DRAM市场正迎来一个从2024年持续至2027年的“前所未有的四年定价上行周期”,预计到2027年,全球存储市场规模将达到近3000亿美元。

开源证券股份有限公司研报显示,人工智能产业发展需求带动下的存储产品短缺或将至少持续到2027年。其中,DRAM产品需求或将在2027年后才开始回稳,NANDFlash与高容量存储需求可能会持续至2028年甚至更久。

记者了解到,当前,产业链上下游企业正积极研发创新、加大生产能力建设,抢抓市场机遇。

在产业链上游设备端,华海清科股份有限公司相关负责人在业绩说明会上表示,2025年第三季度,新品类产品多点突破,公司首台12英寸低温离子注入机iPUMA-LT顺利出机,12英寸晶圆边缘修整装备Versatile-DT300实现批量出货。

在产业链中下游制造端,深圳佰维存储科技股份有限公司在人工智能端侧领域通过自研主控芯片、固

算法与先进封装能力实现差异化竞争,产品覆盖人工智能手机、人工智能个人电脑、人工智能眼镜、具身智能等领域。

袁帅表示:“对于产业链上游企业而言,存储设备国产化率提升是重要机遇,相关企业应把握这一窗口期。对于产业链中下游企业而言,应当积极把握人工智能终端产品广阔市场,紧贴市场需求。”

隐忧逐步显现

尽管江波龙、香农芯创等头部企业股价此前持续狂飙,但存储芯片板块整体“透支预期、偏离基本面”的隐忧已逐步显现,市场分歧在11月11日的交易中尤为突出。

板块内约80只存储概念股中仅14只收涨,多数标的跟随指数走弱,资金对板块的态度从前期的集体追捧转向明显分化。

这种分歧的背后,是部分资金对板块估值的担忧——前期头部企业的持续上涨让市场开始警惕“预期透支”的风险。

业内人士认为,不排除二级市场部分投资者选择获利回吐,止盈离场,通过兑现收益规避潜在回调;但板块此前积累的乐观情绪尚未完全消化,若后续行业基本面不及预期,仍需警惕估值向基本面回归的压力。

当然,在国内包括阿里、腾讯、字节在内的一众互联网大厂都进入算力竞赛的背景下,存储板块不用盲目追高,但也无须悲观。

苏商银行特约研究员高政扬表示,本轮存储芯片风口源于供给收缩与AI需求爆发间的矛盾,国际大厂战略调整为国产存储打开了产品替代、技术追赶的窗口期。

长远来看,AI算力的长期爆发与国产存储产业升级的大势所趋,都让行业成长逻辑具备扎实支撑,只是短期需警惕周期波动,理性把握节奏。

重庆商报综合证券日报、北京商报、金融界

